

# ツェナーダイオード内蔵型MOSFET(バリスタ内蔵リレー駆動用)

## バリスタ内蔵リレー駆動用に耐圧をアップし破壊耐量を向上!

### INKE211BP1、INKE211CP1

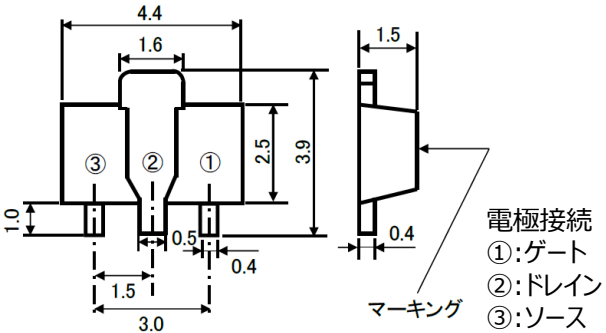
□概要  
 INKE211BP1、INKE211CP1は、バリスタを内蔵した高インダクタンスのリレーを駆動するため、ツェナーダイオード内蔵型MOSFET INKE211AP1をベースとして、Zeダイオードの面積および耐圧をアップし破壊耐量を向上させた製品になります。

- 用途
- ・リレー駆動回路
  - ・モータードライバ回路
  - ・点火装置

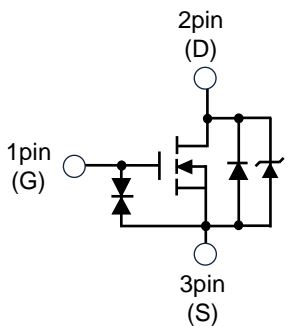
□最大定格

形名	最大定格		
	V <sub>DSS</sub> [V]	I <sub>D</sub> [A]	V <sub>GSS</sub> [V]
INKE211BP1	70	2	20
INKE211CP1	75	2	20

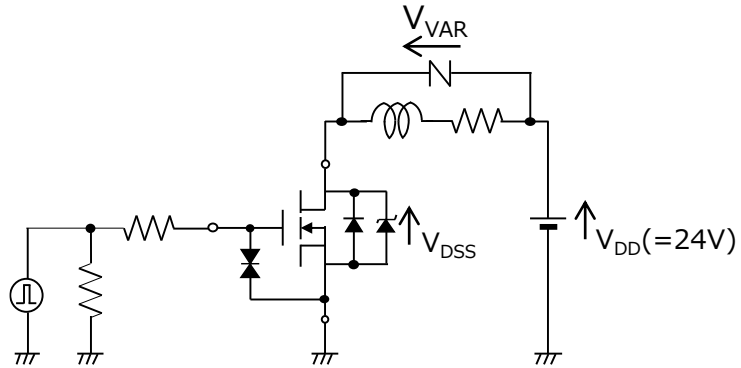
□外形図 単位(mm)



□等価回路



□アプリケーション  
 バリスタ内蔵高インダクタンスリレーの駆動回路



リレーにバリスタが付いていることを考慮した場合は、アバランシェ動作時にMOSFETのD-S間Zeに印加される電圧V<sub>DSS</sub>は、バリスタの電圧V<sub>VAR</sub>とV<sub>DD</sub>を足した値となります。

$$V_{DSS} = V_{VAR} + V_{DD}$$



弊社製品INKE211AC1  
 リレー(SJ-1SG)耐久10個未満  
 V<sub>DSS</sub>=54V(テスト電特)



弊社製品INKE211AC1  
 リレー(SJ-1SG)耐久15個  
 V<sub>DSS</sub>=68V(テスト電特)